

## 33-34 Электрическая ёмкость. Конденсаторы.

### Энергия электрического поля

## 2. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ИХ РАСЧЕТ

### 2.1. Электрическая емкость. Конденсаторы

Если к двум электродам (проводникам), разделенным диэлектриком, приложить постоянное электрическое напряжение  $U$ , то электроды приобретут одинаковые по величине и противоположные по знаку электрические заряды. Абсолютная величина заряда  $q$  на каждом из электродов пропорциональна напряжению  $U$ :

$$q = CU, \quad (2.1)$$

где  $C$  – электрическая емкость.

*Единица измерения электрической емкости [C] – фарад (Ф).*

Электрическая емкость электродов, разделенных диэлектриком, зависит от размеров и формы электродов, расстояния между ними, от свойств диэлектрика и не зависит ни от электрического заряда  $q$ , ни от напряжения  $U$  (за исключением использования диэлектриков, изменяющих диэлектрическую проницаемость при изменении напряженности  $E$  электрического поля).

Электрическую емкость подобных систем приходится определять и учитывать при проектировании и расчетах электротехнических и радиотехнических устройств и установок. В электротехнике и радиотехнике широко применяют устройства, специально созданные для использования их электрической емкости, которые называют *электрическими конденсаторами*. Графическое изображение конденсатора в схеме электрической цепи показано на рисунке 2.5.

Фарад – очень крупная единица емкости, поэтому в практических расчетах емкость  $C$  измеряется в более мелких единицах – микро- и пикофарадах:

$$1 \text{ мкФ} = 10^{-6} \text{ Ф}; \quad 1 \text{ пФ} = 10^{-12} \text{ Ф}.$$



### 2.2. Поле и электрическая емкость плоского конденсатора

Плоский конденсатор имеет две металлические пластины, разделенные диэлектриком (рис. 2.1).

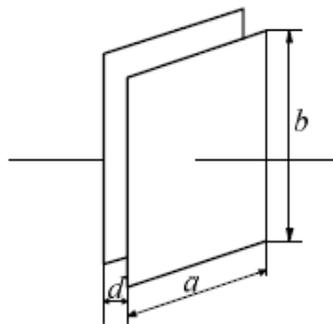


Рис. 2.1. Плоский конденсатор

Расстояние между пластинами обычно мало по сравнению с их длиной и шириной, т. е.  $d \ll a$  и  $d \ll b$ . Если на пластины подать напряжение, то почти все свободные заряды пластин практически равномерно распределятся по внутренним, обращенным друг к другу поверхностям пластин. Искажением поля по краям пластин можно пренебречь. В пространстве между пластинами поле можно считать равномерным, т. е. вектор электрического смещения  $\vec{D}$  постоянен по величине и направлен по нормали к поверхности пластин (рис. 2.2).

Поле с внешней стороны пластин в связи с малой плотностью электрических зарядов пренебрегаем.

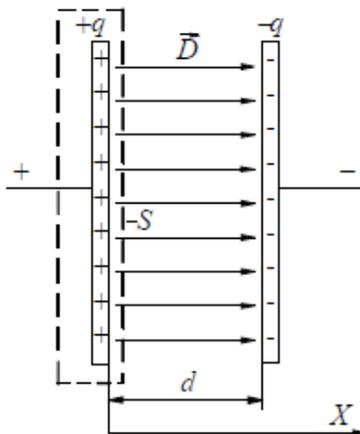


Рис. 2.2. Поле плоского конденсатора

Охватим заряд  $q$  одной из пластин замкнутой поверхностью. След этой поверхности показан на рисунке 2.2 штрихами. Одна сторона этой поверхности идет внутри конденсатора параллельно пластинам.

В соответствии с теоремой Гаусса поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность  $S$

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q.$$

Поле практически имеется только в пространстве между пластинами, причем векторы  $\vec{D}$  и  $d\vec{S}$  совпадают по направлению и величина электрического смещения  $\vec{D}$  во всех точках поля одинакова, поэтому

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = DS = q,$$

где  $S = ab$  – площадь поверхности пластины.

Следовательно,  $D = \frac{q}{S}$ , а напряженность электрического поля при однородном и изотропном диэлектрике по выражению (1.3)

$$E = \frac{q}{\epsilon_a S}.$$

Для нахождения электрической емкости  $C$  конденсатора напряжение  $U$  между пластинами выразим через заряд  $q$ . Так как поле между пластинами равномерное, то по уравнению (1.2)

$$U = Ed = \frac{q}{\epsilon_a S} d.$$

Электрическая емкость конденсатора  $C = \frac{q}{U} = \frac{q\epsilon_a S}{qd}$ .

В окончательном виде

$$C = \epsilon_a \frac{S}{d}. \quad (2.2)$$

Как видно из уравнения (2.2), емкость  $C$  зависит от геометрических размеров пластин, их взаимного расположения, электрических свойств диэлектрика.

Увеличения емкости можно достигнуть увеличением поверхности пластин  $S$ , выбором диэлектрика с высокой относительной диэлектрической проницаемостью  $\epsilon_r$  и уменьшением расстояния между пластинами  $d$ . Однако уменьшение расстояния  $d$  ограничено электрической прочностью диэлектрика, с уменьшением  $d$  увеличивается напряженность:

$$E = \frac{U}{d}.$$

Любой диэлектрик при определенной напряженности электрического поля пробивается.

**Пример 2.1.** Между одной из пластин плоского конденсатора и наполнителем (парафином) образовался слой воздуха (рис. 2.3).

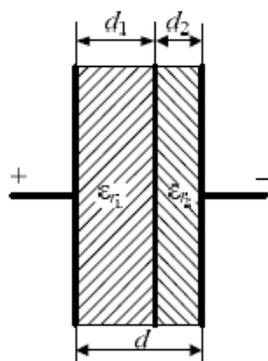


Рис. 2.3. Плоский конденсатор с двумя слоями диэлектрика

Площадь поверхности пластины конденсатора  $S = 200 \text{ см}^2$ , толщина слоя парафина  $d_1 = 0,5 \text{ см}$ , толщина воздушного слоя  $d_2 = 0,1 \text{ см}$ , относительная диэлектрическая проницаемость парафина  $\epsilon_{r1} = 2$ , воздуха  $\epsilon_{r2} = 1$ .

Пробивные напряженности для парафина и для воздуха соответственно равны:

$$E_{\text{пр}_1} = 150 \frac{\text{кВ}}{\text{см}}; \quad E_{\text{пр}_2} = 30 \frac{\text{кВ}}{\text{см}}.$$

Определить, при каком напряжении этот конденсатор будет пробит, какое напряжение выдержит конденсатор без дефекта (расстояние между пластинами  $d = 0,6 \text{ см}$ ).

**Решение.** Для двухслойного плоского конденсатора напряжение между пластинами

$$U = d_1 E_1 + d_2 E_2.$$

Электрическое смещение  $D = \frac{q}{S}$  не зависит от свойств диэлектрика.

Напряженности

$$E_1 = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r_1}}, \quad E_2 = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r_2}},$$

т. е. напряженность будет больше в слое воздуха.

Выразим:

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_{r_2} E_2; \quad E_1 = \frac{E_2 \varepsilon_{r_2}}{\varepsilon_{r_1}}.$$

Для определения напряжения, при котором конденсатор будет пробит, запишем:

$$U = d_1 \frac{E_2 \varepsilon_{r_2}}{\varepsilon_{r_1}} + d_2 E_2;$$

$$U = 0,5 \frac{30 \cdot 1}{2} + 0,1 \cdot 30 = 7,5 + 3 = 10,5 \text{ кВ.}$$

Конденсатор без дефекта выдержит напряжение

$$U = d E_1 = 0,6 \cdot 150 = 90 \text{ кВ.}$$

### 2.3. Поле и электрическая емкость цилиндрического конденсатора

Цилиндрический конденсатор представляет собой два разделенных изоляцией проводящих цилиндра с совпадающими осями, т. е. соосных или коаксиальных (рис. 2.4, а). Примером цилиндрического конденсатора может служить коаксиальный кабель, у которого внутренний провод прокладывается строго по оси кабеля, а другой в виде металлической оплетки охватывает изоляцию центрального проводника. Коаксиальные кабели предназначены для передачи электроэнергии высокой частоты.

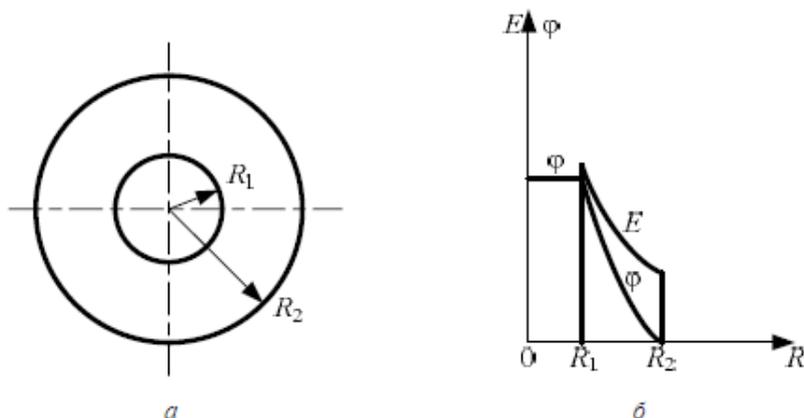


Рис. 2.4. Цилиндрический конденсатор (а), напряженность  $E$  и потенциал  $\varphi$  поля конденсатора в зависимости от  $R$  (б)

Пусть внутренний цилиндр радиусом  $R_1$  имеет на единицу длины заряд  $+\tau$ , а внешний цилиндр радиусом  $R_2$  — заряд  $-\tau$ .

Поле зарядов, имеющих на цилиндрической поверхности внутреннего проводника, можно заменить полем зарядов, расположенных на оси кабеля. Так как длина кабеля велика по сравнению с его диаметром, то применимы уравнения (1.7), (1.8) (см. п. 1.12).

Напряженность электрического поля между проводящими цилиндрами на расстоянии  $R$  от оси кабеля по уравнению (1.8)

$$E = \frac{\tau}{2\pi R\epsilon_a}.$$

Напряжение между цилиндрами определяется интегралом:

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dR = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_a} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dR}{R} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_a} \ln \frac{R_2}{R_1}. \quad (2.3)$$

Электрическая емкость цилиндрического конденсатора и коаксиального кабеля на единицу длины

$$C = \frac{\tau}{U} = \frac{2\pi\epsilon_a}{\ln \frac{R_2}{R_1}}. \quad (2.4)$$

На рисунке 2.4, б показаны графики изменения потенциала  $\varphi$  и напряженности  $E$  в зависимости от расстояния  $R$  от оси кабеля. Потенциал на поверхности наружного проводника принят равным нулю. При  $R < R_1$  в проводящем внутреннем цилиндре  $\varphi = \text{const} = U$ ,  $E = 0$ . При  $R > R_2$  напряженность  $E = 0$  согласно теореме Гаусса.

Наибольшее значение напряженности поля имеет у поверхности внутреннего цилиндра ( $R = R_1$ ):

$$E_{\max} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_a} R_1,$$

или, выражая  $\tau$  из формулы (2.3) через  $U$ , получаем

$$E_{\max} = \frac{U}{R_1 \ln \frac{R_2}{R_1}}. \quad (2.5)$$

**Пример 2.2.** Цилиндрический воздушный конденсатор длиной  $l = 20$  см, радиусом внутреннего цилиндра  $R_1 = 0,5$  см и внешнего  $R_2 = 2,5$  см включен под напряжение 20 кВ. Определить емкость конденсатора, заряд конденсатора, максимальную и минимальную напряженности электрического поля.

**Решение.** Электрическую емкость цилиндрического конденсатора длиной  $l$  находим по выражению (2.4):

$$C = \frac{2\pi\epsilon_a l}{\ln \frac{R_2}{R_1}} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,2}{\ln \frac{2,5}{0,5}} = 6,94 \cdot 10^{-12} \text{ Ф}.$$

Заряд конденсатора  $q = CU = 6,94 \cdot 10^{-12} \cdot 20 \cdot 10^3 = 138,9 \cdot 10^{-9}$  Кл.

Заряд конденсатора на единицу длины

$$\tau = \frac{q}{l} = \frac{138,9 \cdot 10^{-9}}{0,2} = 694,7 \cdot 10^{-9} \text{ Кл/м}.$$

Максимальная напряженность поля на поверхности внутреннего цилиндра

$$E_{\max} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{694,7 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,5 \cdot 10^{-2}} = 25 \cdot 10^5 \text{ В/м}.$$

Минимальная напряженность поля у поверхности внешнего цилиндра

$$E_{\min} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 R_2} = 5 \cdot 10^5 \text{ В/м}.$$

**Пример 2.3.** Коаксиальный кабель имеет радиус внутренней жилы  $R_1 = 2$  мм и внешней оболочки  $R_2 = 5$  мм. Определить, под какое напряжение можно включить кабель, если максимальная напряженность поля не должна превышать  $1/3$  пробивной напряженности  $E_{\text{пр}}$  диэлектрика, равной  $2 \cdot 10^4$  кВ/м.

**Решение.** Напряженность поля максимальна на поверхности внутреннего цилиндра. По уравнению (2.5)

$$E_{\text{max}} = \frac{U}{R_1 \ln \frac{R_2}{R_1}}.$$

По условию  $E_{\text{max}} = \frac{E_{\text{пр}}}{3}$ .

Выражаем  $U = \frac{E_{\text{пр}}}{3} R_1 \ln \frac{R_2}{R_1}$ . Подставляем значения величин и получаем  $U = 12,2$  кВ.

## 2.4. Энергия и плотность энергии электрического поля

Система заряженных тел является носителем определенного запаса энергии. Эта энергия сообщается системе внешними источниками в процессе образования зарядов и может быть вновь возвращена источникам или преобразована в другие виды энергии при уменьшении зарядов.

Для получения выражения энергии, запасенной в системе заряженных проводящих тел, рассмотрим работу, совершаемую внешними источниками при образовании зарядов системы.

Пусть конденсатор с емкостью  $C$  через резистор с сопротивлением  $R$  подключен к источнику энергии. Часть элементарной работы, производимой источником энергии при увеличении заряда конденсатора на  $dq$ , равна  $u_c dq$ . Эта работа идет на создание запаса энергии в электрическом поле конденсатора, обозначим ее  $dW_3$ :

$$dW_3 = u_c dq.$$

Для конденсаторов с диэлектриком, у которого диэлектрическая проницаемость  $\epsilon_r = \text{const}$ , имеем соотношение  $q = C u_c$ . Следовательно,  $dq = C du_c$ , поэтому энергию, запасенную в электриче-

ском поле конденсатора, при изменении напряжения на конденсаторе от 0 до  $U_C$  найдем из выражения

$$W_3 = \int_0^{U_C} C u_C du_C = \frac{CU_C^2}{2}. \quad (2.6)$$

Каждая единица объема диэлектрика, который помещен между электродами конденсатора, является носителем определенного запаса энергии, поэтому можно говорить об **объемной плотности энергии электрического поля**.

$$\frac{W_3}{V} = \frac{CU^2}{2V},$$

где  $V$  – объем диэлектрика, в котором заключена электрическая энергия  $W_3$ .

*Энергия электрического поля* измеряется в джоулях (Дж), а *объемная плотность энергии* – в джоулях на кубический метр (Дж/м<sup>3</sup>).

Объемную плотность энергии электрического поля рассмотрим на примере плоского конденсатора.

Емкость плоского конденсатора

$$C = \varepsilon_a \frac{S}{d},$$

где  $S$  – поверхность пластины,

$d$  – расстояние между пластинами.

Поле между пластинами равномерное, поэтому  $U_C = Ed$ . Используем эти соотношения в уравнении (2.6) и получим

$$W_3 = \varepsilon_a \frac{SE^2 d}{2} = \varepsilon_a \frac{E^2 V}{2},$$

где  $V = Sd$  – объем диэлектрика, в котором сосредоточено электрическое поле.

Энергия, отнесенная к единице объема поля,

$$\frac{W_3}{V} = \varepsilon_a \frac{E^2}{2} = \frac{DE}{2}, \quad (2.7)$$

где  $D = \varepsilon_a E$ .